



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D213082 S

(45)公告日：中華民國 110 (2021) 年 08 月 01 日

(21)申請案號：109306839

(22)申請日：中華民國 109 (2020) 年 12 月 04 日

(51)LOC.(11)Cl.：13-99

(30)優先權：2020/06/15 日本

2020-011850

(71)申請人：日商東京威力科創股份有限公司 (日本) TOKYO ELECTRON LIMITED (JP)  
日本

(72)設計人：城俊彥 JO, TOSHIKO (JP)；坂下訓康 SAKASHITA, KUNIYASU (JP)

(74)代理人：何愛文；王仁君

(56)參考文獻：

TW D112939

TW D133944

TW D133945

TW D174924

TW D175118

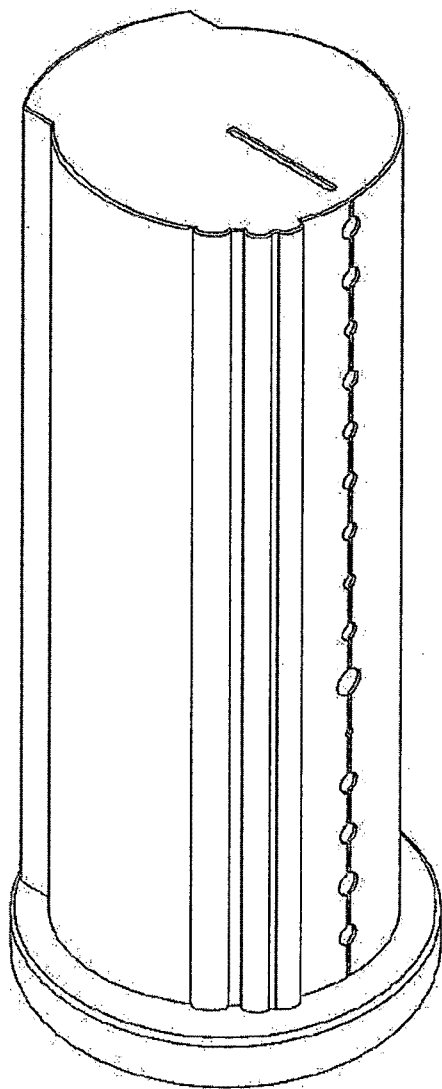
審查人員：朱哲慶

圖式數：11 共 12 頁

(54)名稱

半導體製造裝置用反應管 (三)

代表圖：



【立體圖】

D213082

## 【設計說明書】

【中文設計名稱】半導體製造裝置用反應管(三)

### 【物品用途】

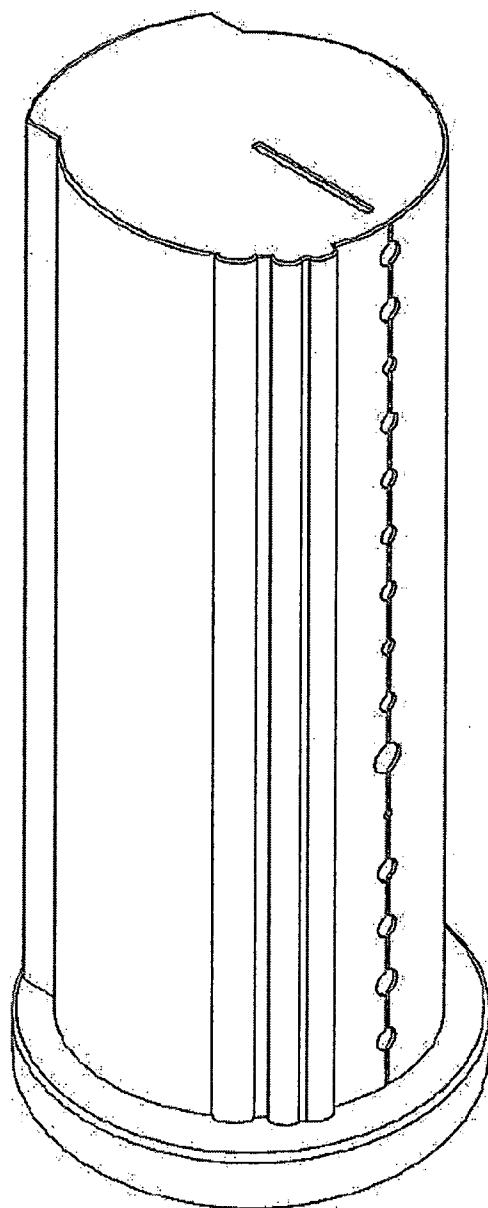
【0001】 本設計物品如表示使用狀態的參考剖面圖所示，係在半導體製造之成膜過程中設置在成膜裝置內，會使製品晶圓與氣體反應的管。具體而言，在本設計物品內積層有製品晶圓的狀態下使氣體流入，以在製品晶圓的表面成膜，但此時，必須使本設計物品內的上下部分之氣體濃度成為均勻。形成在平面部左右中央位置的寬度細之縱長橢圓形狀的孔、及在正面部左右中央位置處配置在上下方向之多個大小孔與將該等多個大小孔在縱方向連貫的寬度細之槽部，皆為用以將流入之氣體排出的氣體通道，而具有使本設計物品內部整體氣體濃度均勻的功能。

### 【設計說明】

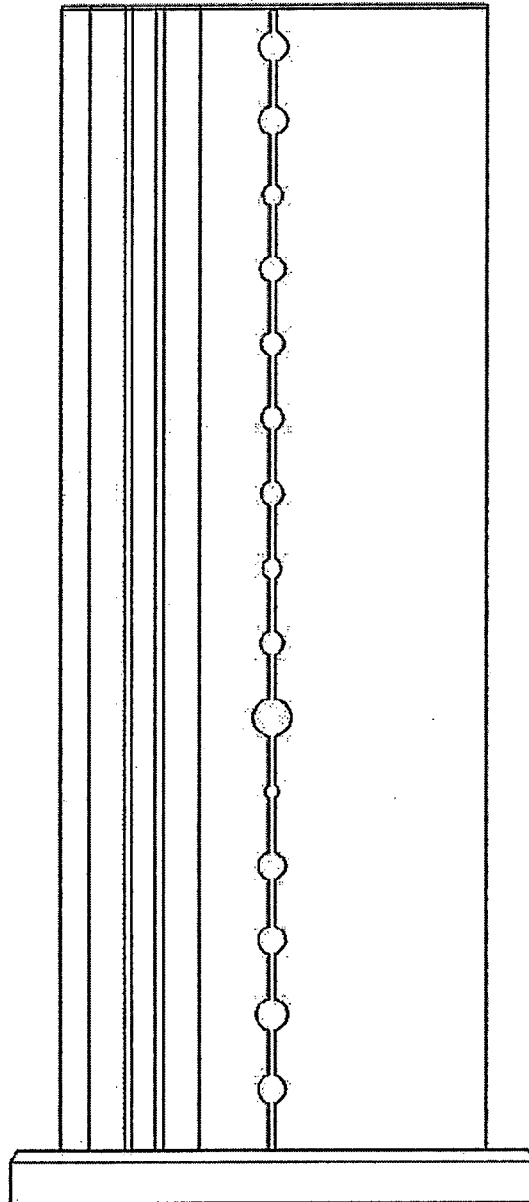
【0002】

【設計圖式】

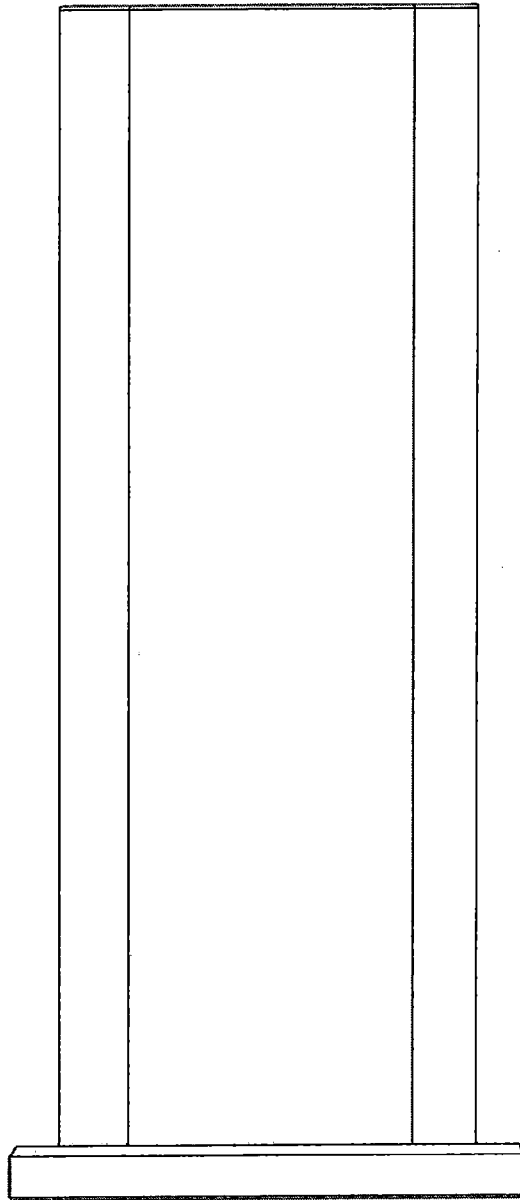
(指定代表圖)



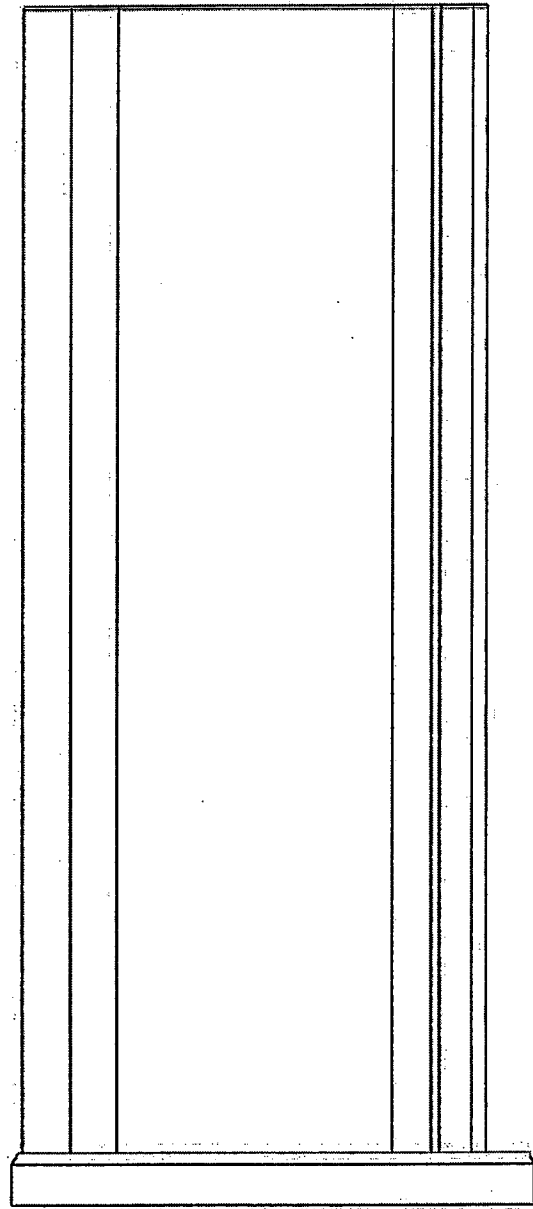
【立體圖】



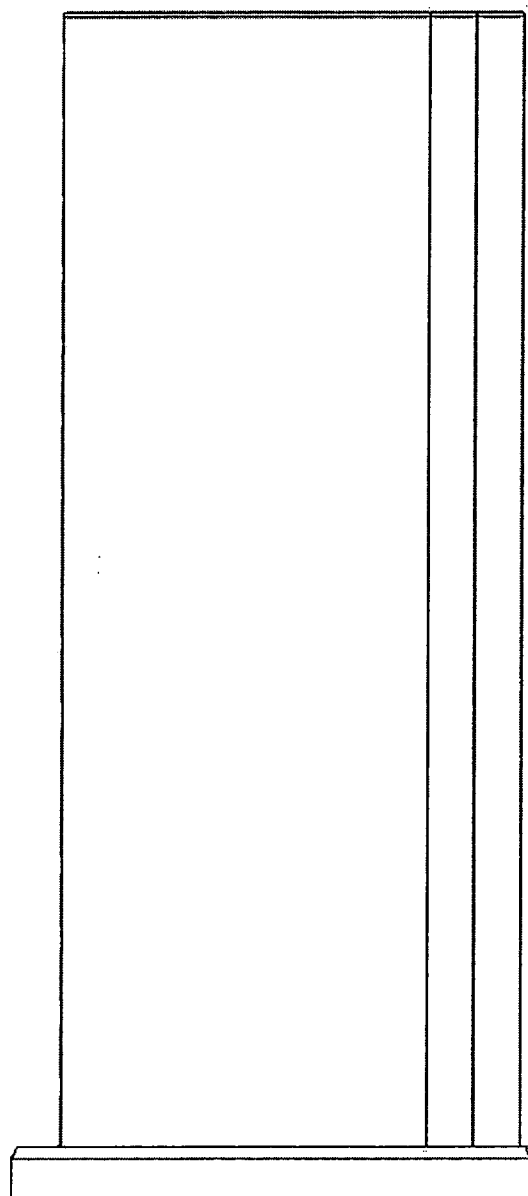
【前視圖】



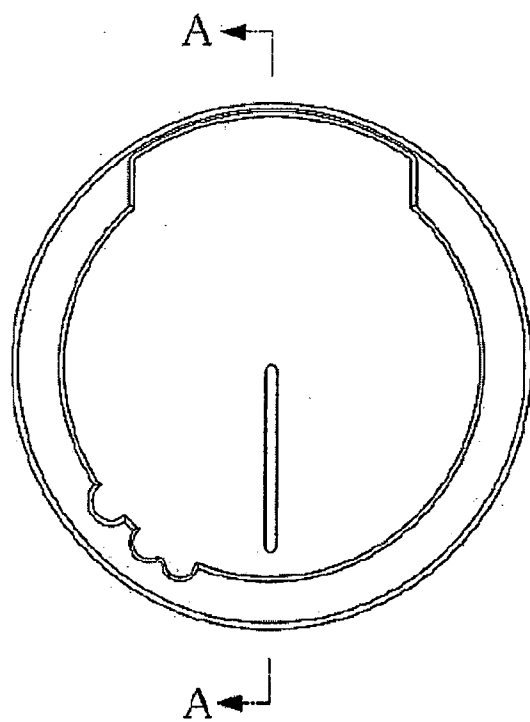
【後視圖】



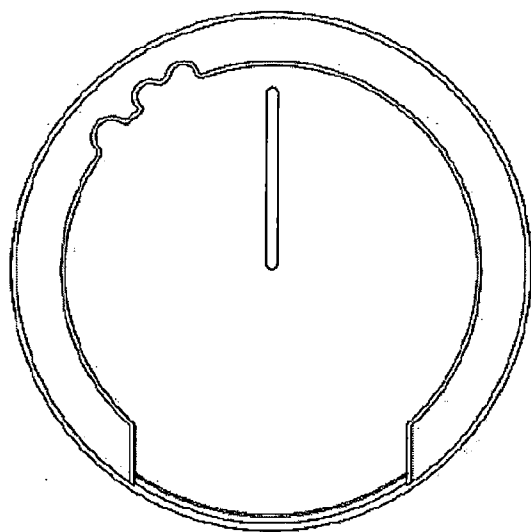
【左側視圖】



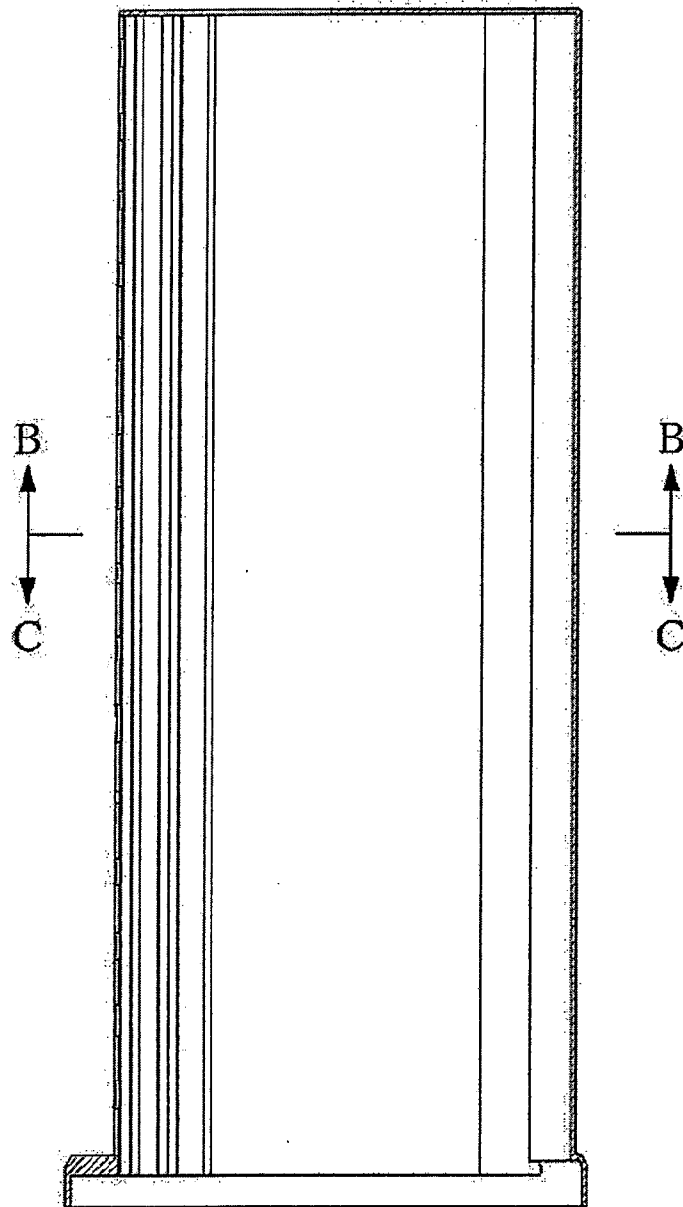
【右側視圖】



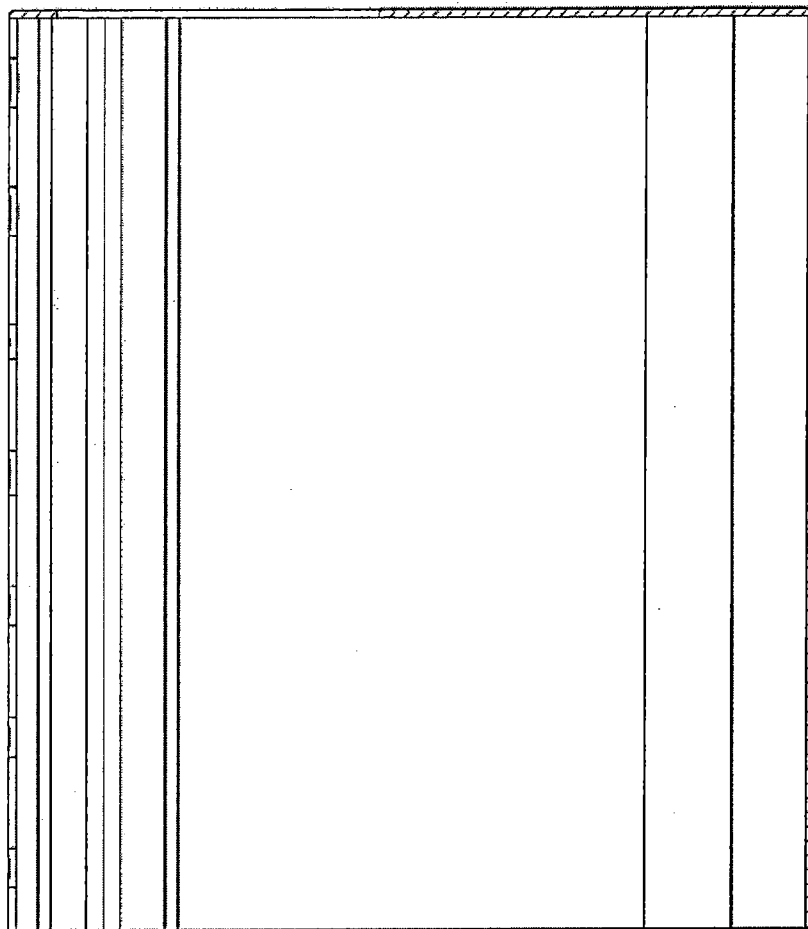
【俯視圖】



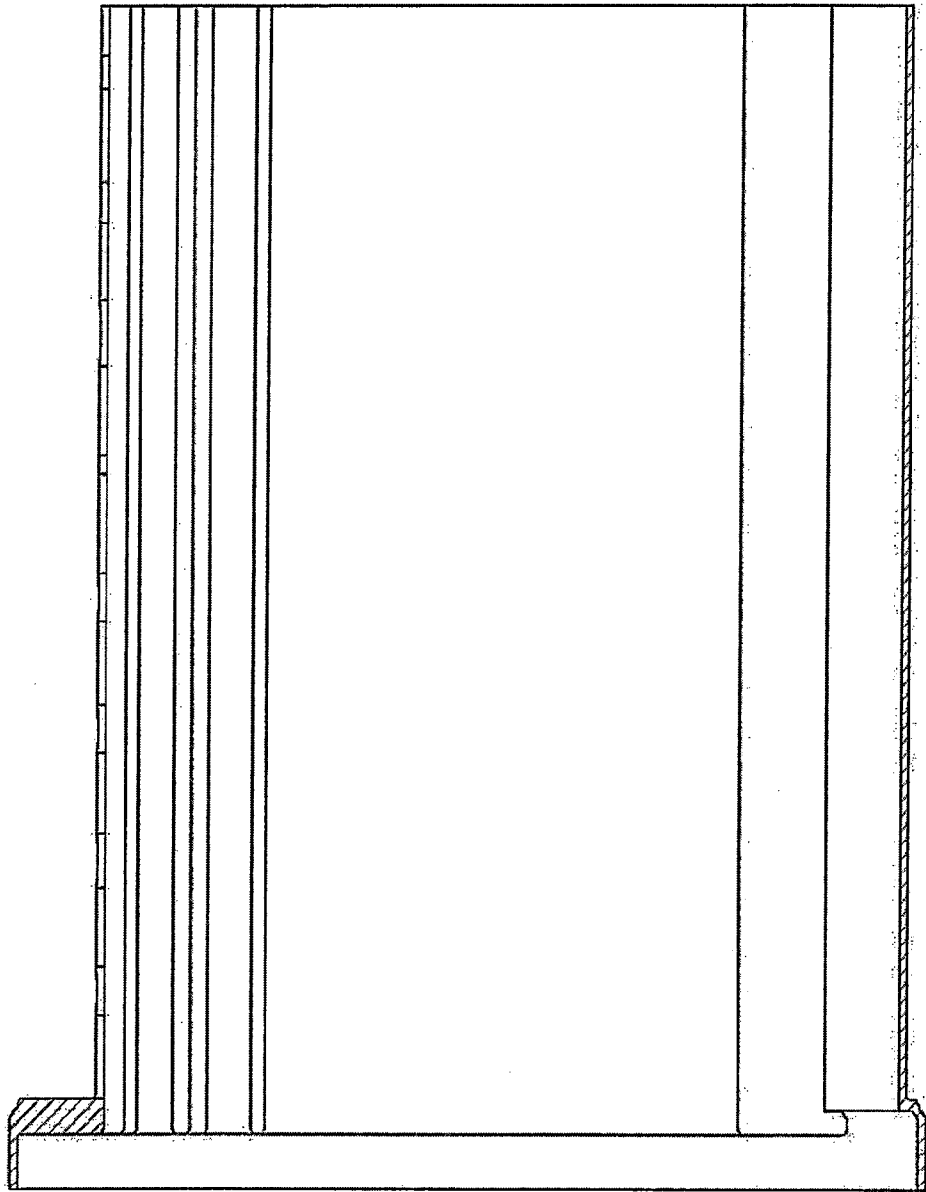
【仰視圖】



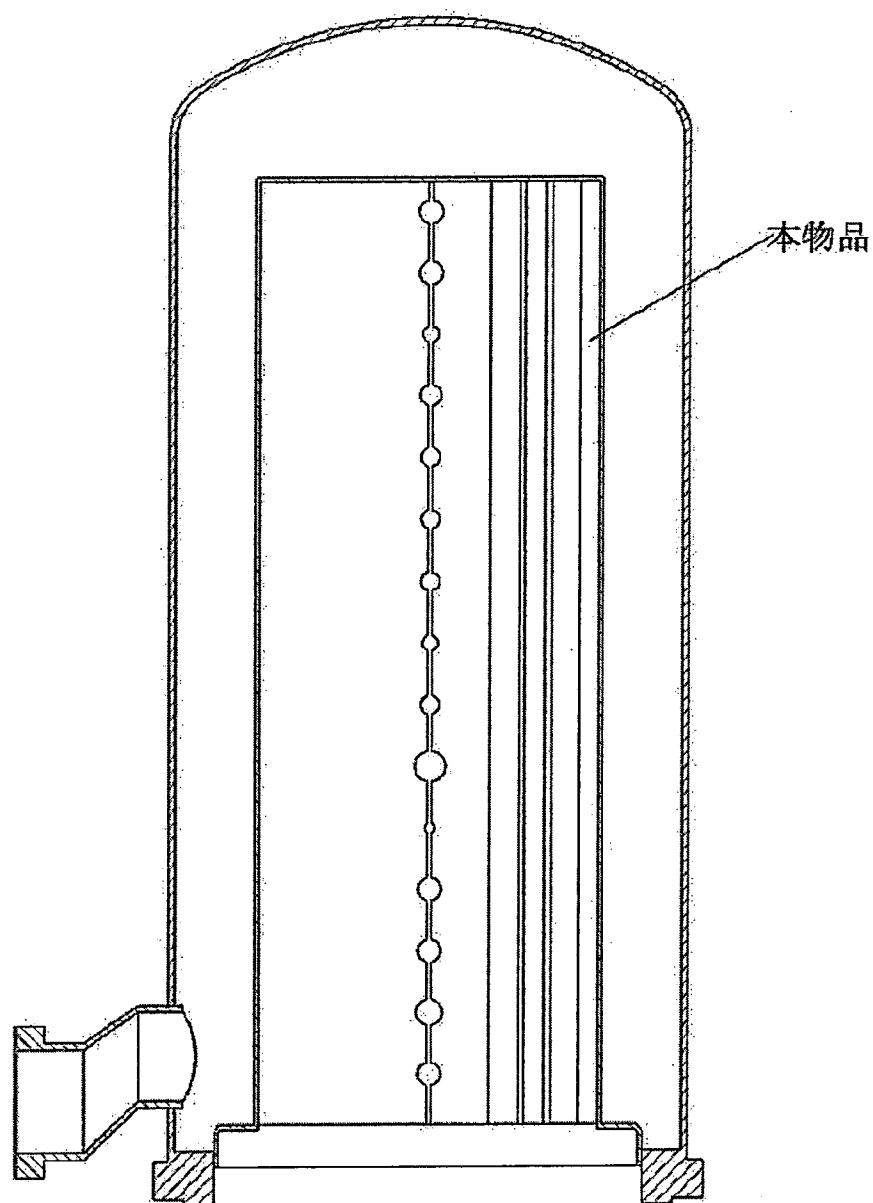
【A-A線剖面圖】



【B-B部分放大圖】



【C-C部分放大圖】



【表示使用狀態的參考剖面圖】